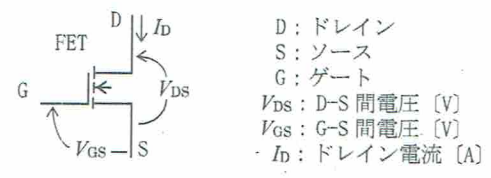


A-6 次の記述は、図に示すNチャンネルMOS形の電界効果トランジスタ(FET)について述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

- (1) 一般に、ゲート・ソース間には、□Aの電圧を加えて用いる。
- (2) FETの相互コンダクタンス g_m は、電圧及び電流の変化分を Δ とすれば $g_m = \square B$ で表される。
- (3) (1)の場合、 $V_{GS} = 0$ [V] のとき I_D は □C。

A	B	C
1 Gに負(-)、Sに正(+)	$\Delta I_D / \Delta V_{DS}$	流れる
2 Gに負(-)、Sに正(+)	$\Delta I_D / \Delta V_{GS}$	流れる
3 Gに正(+)、Sに負(-)	$\Delta I_D / \Delta V_{DS}$	流れない
4 Gに正(+)、Sに負(-)	$\Delta I_D / \Delta V_{GS}$	流れる
5 Gに正(+)、Sに負(-)	$\Delta I_D / \Delta V_{GS}$	流れない



Handwritten notes and diagrams:

- Top left: A schematic of an N-channel MOSFET with red annotations. "G 電圧" (Gate voltage) is written above the gate terminal. "電流" (Current) is written on the left. The source terminal is labeled "S".
- Top right: Two MOSFET symbols. The first is labeled "インダクタ" (Inductor) and the second "コンデンサ" (Capacitor). Below them are two graphs showing I_D vs V_{GS} . The first graph shows a curve starting from the origin, and the second shows a straight line passing through the origin.
- Right side: A table of ratios: $\frac{I_D}{V_{GS}}$ and g_m . Below these are three options: $\frac{I_D}{V_{GS}}$, $\frac{I_D}{V_{DS}}$, and $\frac{I_D}{V_{GS}}$.

